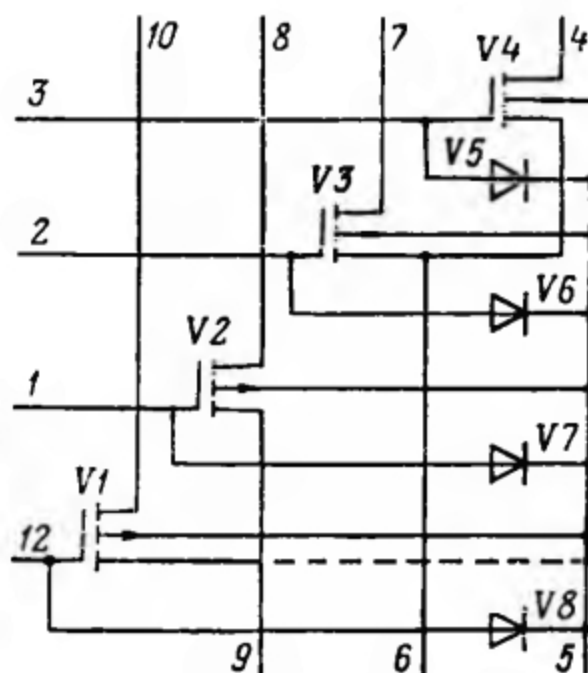


190КТ2, К190КТ2

Микросхемы выполнены на МДП-транзисторах с индуцированным каналом p -типа. Предназначены для коммутации электрических сигналов. Конструктивно оформлены в корпусе типа 301.12-1 (серия 190) или в прямоугольном пластмассовом типа 201.14-1 (серия К190).

Микросхемы используются как четырехканальный коммутатор.



Принципиальные схемы ИМС 190КТ2, К190КТ2

Параметры	Режим измерения	190КТ2
		К190КТ2
$U_{зи\text{ пор}}$, В	$U_{ип} = 0$; $I_c = 10$ мкА, $U_{си} = -5$ В	-6
$I_{з\text{ ут}}$, нА	$U_{зи} = -30$ В; $U_{си} = U_{ип} = 0$	≤ 30
$I_{с\text{ нач}}$, нА	$U_{ип} = U_{зи} = 0$; $U_{си} = -25$ В	≤ 50
$I_{п}$, нА	$U_{ип} = 25$ В	≤ 400
$R_{отк}$, Ом	$U_{зи} = -20$ В, $U_{ип} = 0$; $I_c = 1$ мА	≤ 150
$R_{отк}$, Ом	$U_{зи} = -10$ В; $U_{ип} = 0$; $I_c = 1$ мА	≤ 50
$C_{11н}$, пФ	$U_{си} = -15$ В; $U_{ип} = 0$; $f = 1$ МГц	≤ 120
$C_{12н}$, пФ	$U_{си} = -15$ В; $U_{ип} = 0$; $f = 1$ МГц	≤ 24
$C_{22н}$, пФ	$U_{си} = -15$ В; $U_{ип} = 0$; $f = 1$ МГц	≤ 9
		15

¹ При температуре 25 ± 10 °С

Предельно допустимые значения параметров и режимов эксплуатации указаны в следующей таблице.

$U_{си}$, В	$U_{зи}$, В	$U_{зс}$, В	$U_{ип}$, В	$U_{зп}$, В	I_c , мА	$P_{\text{рас макс}}$, мВт
-25	-30	-30	25	-30	10^1	200

¹ Для микросхемы 190КТ1, для ИМС 190КТ2 $I_{с.мак} = 50$ мА.